

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2008-227495(P2008-227495A)

【公開日】平成20年9月25日(2008.9.25)

【年通号数】公開・登録公報2008-038

【出願番号】特願2008-59321(P2008-59321)

【国際特許分類】

H 01 L 29/861 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/91 L

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月4日(2011.3.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

2端子半導体整流デバイスであって、

P++層と、

該P++層の実質的に下方において該層に隣接して配置されたP-ボディと、

該P-ボディの実質的に下方において該ボディに隣接して配置されたN-ドリフト領域と、

該N-ドリフト領域の実質的に下方に配置されたN+基板と、

前記P++層の実質的に下方において該層に隣接して配置された高次のシリサイド領域と、

前記N-ドリフト領域、前記P-ボディ領域、前記P++層、及び、チタンシリサイドの前記領域、のうちの少なくとも1つの実質的に上方において該少なくとも1つに隣接して配置され、ゲート誘電体として機能する酸化物の層と、

該酸化物の層の実質的に上方において該層に隣接して配置されたポリシリコンの層と、

該ポリシリコンの層の実質的に上方において該層に隣接して配置されたチタンの層と、を具備することを特徴とする半導体整流デバイス。

【請求項2】

前記チタンが約300の厚みを有する、請求項1に記載の半導体整流デバイス。

【請求項3】

前記チタンの層の実質的に上方において該層に隣接して配置された窒化チタンの層をさらに含む、請求項1に記載の半導体整流デバイス。

【請求項4】

前記窒化チタンの層が約500の厚みを有する、請求項3に記載の半導体清流デバイス。